

2SD1571

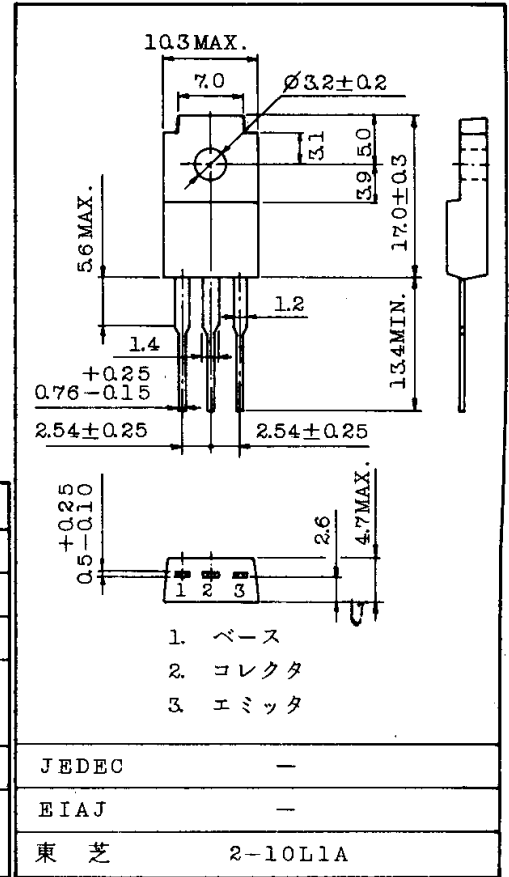
シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

○ 高電圧スイッチング用

特 長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CB0} = 800V$
- ・ 飽和電圧が低い。 : $V_{CE(sat)} = 1.0V$ (最大)
($I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$)
- ・ スwitching時間が速い。 : $t_f = 1.0\mu s$ (最大)
- ・ 絶縁ブッシング, マイカ等が不要なTO-220相当のアイソレーションパッケージです。

単位: mm



最大定格 ($T_c = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	800	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	400	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	DC	I_C	3
	パルス	I_{CP}	6
ベース電流	I_B	1.5	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	P_C	2.0
	$T_c = 25^\circ C$		30
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_c = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 800V, I_E = 0$	—	—	1	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	1	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, I_B = 0$	400	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$	8	—	—	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$	10	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$	—	—	1.5	V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	75	—	pF
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_E = -0.1A$	—	4	—	MHz
下 降 時 間	t_f	<p> $20\mu s$ $V_{CC} = 200V$ I_{B1} 入力 I_{B2} I_C 100Ω 出力 $I_{B1} = -I_{B2} = 0.05A$ $I_C = 0.5A$ 繰り返し周期 < 2% </p>	—	—	1.0	μs